### FACULTAD DE INGENIERIA



MECANICA Y ELECTRICA

Aperimentos de l'Aperimentos de l'Aperim

VDD=12V

RD ₹ 2.2K 10 MF

10 MF

2NS951

RS1 ₹ 68 Ω

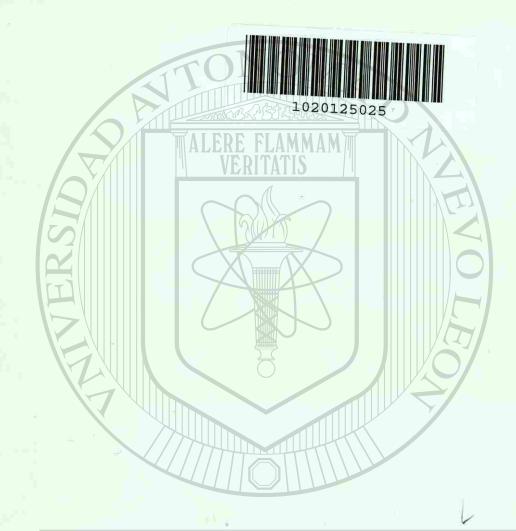
RS2 ₹ 470 Ω ★ 100 MF

RS2 ₹ 470 Ω ★ 100 MF

7860 2

Ing. Juan Sarabia Ramos Departamento de Electrónica







TRONICA I

MATRICULA: UNIVERSIDAD AUTÓN

LABORATORIO: BRIGADA:

NOMBRE:

TELEFONO:

DIRECCIÓN GENERAL CATEDRATICO: \_\_\_\_





TK7860



EXPERIMENTOS
DE
ELECTRONICA I

Puente rectificador de l'ampere y 50 volta.

Diodo 1801a.

Resistancia de 1812

EXP101 EXP102 EXP103 EXP104 EXP105 EXP106 EXP107 EXP108 EXP109 EXP110 CURVA CARACTERÍSTICA DEL DIODO
RECTIFICADOR TIPO PUENTE
REGULADOR ZENER
CIRCUITO RECORTADOR
CIRCUITO SUJETADOR
CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL TRANSISTOR BIPOLAR
CIRCUITO DE POLARIZACIÓN EMISOR-COMUN
DISEÑO DE UN AMPLIFICADOR EMISOR-COMUN
CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL FET
DISEÑO DE UN AMPLIFICADOR SURTIDOR COMUN

### UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



RECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Ing. Juan Sarabia Ramos Departamento de Electrónica

od. 29-04 EH 10140 Dens de l'embrio

TK7860



EXPERIMENTOS
DE
ELECTRONICA I

Puente rectificador de l'ampere y 50 volta.

Diodo 1801a.

Resistancia de 1812

EXP101 EXP102 EXP103 EXP104 EXP105 EXP106 EXP107 EXP108 EXP109 EXP110 CURVA CARACTERÍSTICA DEL DIODO
RECTIFICADOR TIPO PUENTE
REGULADOR ZENER
CIRCUITO RECORTADOR
CIRCUITO SUJETADOR
CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL TRANSISTOR BIPOLAR
CIRCUITO DE POLARIZACIÓN EMISOR-COMUN
DISEÑO DE UN AMPLIFICADOR EMISOR-COMUN
CURVAS CARACTERÍSTICAS DEL FET
DISEÑO DE UN AMPLIFICADOR SURTIDOR COMUN

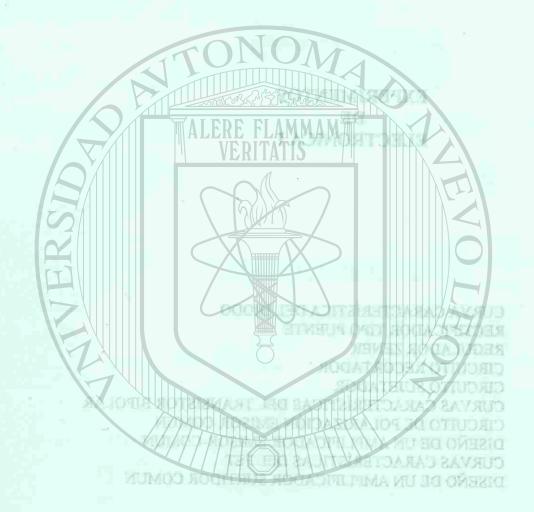
### UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN



RECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

Ing. Juan Sarabia Ramos Departamento de Electrónica

od. 29-04 EH 10140 Dens de l'embrio



### EXP101

### CURVA CARACTERISTICA DEL DIODO

### I.- OBJETIVO.

Obtener la curva característica del diodo, utilizando el osciloscopio como un trazador de

### II.- LISTA DE MATERIAL Y EQUIPO.

- Osciloscopio
- Microcomputadora 386
- Puente rectificador de 1 ampere y 50 volts
- Transformador 120/12 VCA, 250mA.
- Resistencia de  $1K\Omega$
- Resistencia 3.3KΩ

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

EXP101-1 FIME, Depto. de Electrónica

### III.- CIRCUITO DEL EXPERIMENTO:

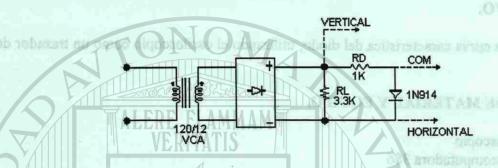


Figura 1. Obtención de la curva característica de un diodo.

### IV.- TEORIA PRELIMINAR

Una señal rectificada de onda completa, se usará como fuente de excitación para un circuito serie formado por el diodo de prueba y una resistencia limitadora (fig. 1).

V. PROCEDIMIENTO:

El voltaje en la resistencia RD de 1k, es proporcional a la corriente del diodo con un factor de conversión de 1 volt por cada miliampere de corriente. Esta señal de voltaje servirá para deflexionar el haz de electrones del osciloscopio operando en modo XY en dirección vertical

La caída de voltaje en el diodo se utilizará para deflexionar el haz de electrones horizontalmente.

horizontal para acomodár la curvar Cop. al yezpigado cabbración borivantal ajura prata tener

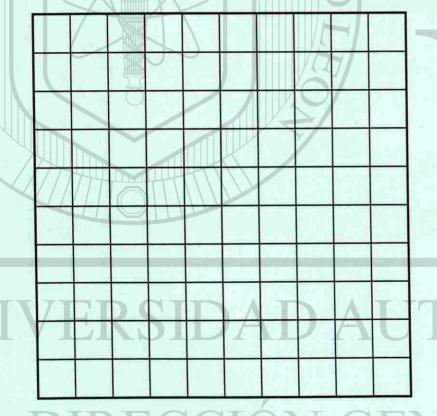
# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

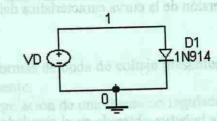
EXP101-2 FIME, Depto. de Electrónica EXP101-3 FIME, Depto. de Electrónica

### V.- PROCEDIMIENTO:

- 1.- Implementar el circuito de la fig. 1.
- 2.- Conecte al osciloscopio los puntos C, X, Y tal y como se indica en el diagrama.
- 3.- Ajuste los controles del osciloscopio para operar en modo XY; ganancia vertical 2 V/div, ganancia horizontal 1V/div. Asegúrese de que los vernieres de calibración estén en la posición correcta.
- 4.-Observe la curva característica del diodo; haga uso de los controles de posición vertical y horizontal para acomodar la curva. Con el vernier de calibración horizontal ajuste para tener una escala horizontal de 0.5 V/div.
- 5.- Dibuje lo mas aproximado posible la curva característica del diodo, en la siguiente cuadrícula, indicado los valores de las escalas de corriente y voltaje en el diodo.



VI.- SIMULACION



VU-REPORTE.

Figura 2. Obtención de la curva característica del diodo, mediante simulación.

1.- Crear el archivo EXP01.CIR, con los datos de la fig. 2.

CURVA CARACTERISTICA DEL DIODO

\*Archivo EXP01.CIR

VD 1 0 DC 0

D1 1 0 D1N914

.LIB DIODE.LIB
.DC LIN VD 0 1.5 0.05
.PRINT V(1), I(D1)
.PROBE
.END

2.- Obtener en el graficador de alta resolución el trazo de la corriente en el diodo.

Add-Trace I(D1)

3.- Agregar el trazo de una linea de carga de C.D. Suponiendo VCC = 3V y R =  $150\Omega$ .

Add-Trace (3-VD)/0.15K.

4.- Determinar el valor del punto de operación:

IDQ = VDO =

- 5.- Imprima la gráfica.
- 6.- Observe en el archivo de salida, la impresión de los valores del comando .PRINT. Use la secuencia FILE, BROWSE.

1.-Explique el porqué de la inversión de la curva característica del diodo, obtenida en el paso 5 del procedimiento.

2.-Dibuje en la misma cuadrícula la curva obtenida en el simulador, explique el porqué de la diferencia.

3.-Dibuje en la cuadrícula una línea de carga de CD, con los siguientes valores:

Vcc=3V

 $R=150\Omega$ 

4.-Determine con la ayuda del trazo anterior el punto de operación.

IDQ =

VDQ =

EXP102 TANDING LAIG OTTOORID - NII

### RECTIFICADOR TIPO PUENTE

### I.- OBJETIVOS.

- Observar y medir las formas de onda de voltaje presentes en un circuito rectificador de onda completa tipo puente.
- Obtener la curva de regulación de una fuente no regulada.
- ☐ Obtener la curva de rizado de una fuente no regulada.
- Observar y medir la corriente de pico repetitiva en los diodos.
- Observar el efecto que produce la modificación del valor del capacitor del filtro.

### II.- LISTA DE MATERIAL Y EQUIPO.

- 1 Osciloscopio.
- Microcomputadora 386.
- Multimetro digital.
- 1 Transformador 120/12 VCA.
- 4 Diodos 1N4148.
- 2 Capacitores electrolíticos de 330μf, 50V.
- 10 Resistencias de 100Ω, 3W.

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

EXP101-6 FIME, Depto. de Electrónica

EXP102-1 FIME, Depto. Electrónica

### III.- CIRCUITO DEL EXPERIMENTO.

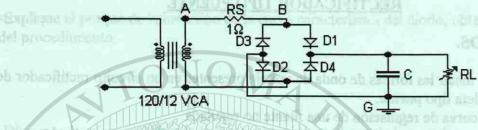


Figura 1. Circuito rectificador tipo puente

### IV.- TEORÍA PRELIMINAR.

La señal rectificada de onda completa, se puede observar en el osciloscopio en modo de C.D. y entre los puntos O y G, siempre y cuando RL este conectado y el capacitor desconectado.

V. PROCEDIMIENTO.

Si el capacitor C se conecta, la señal pulsante se filtra, obteniéndose un rizado cuya amplitud es función directa de la corriente de carga e inversa al valor del capacitor. El rizado puede observarse en el osciloscopio en el modo de C.A.

La resistencia RS tiene un valor prácticamente despreciable y su propósito es monitorear la corriente en los diodos. La caída de voltaje entre los puntos A y B es proporcional a dicha corriente.

## UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE N DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLI

EXP102-2 FIME, Depto. Electrónica EXP102-3 FIME, Depto. Electrónica

#### V.- PROCEDIMIENTO.

- 1.- Implementar el circuito de la figura 1. La resistencia RL es un arreglo de resistencias de  $100\Omega$  y el capacitor C puede tener un valor de  $330\mu f$  o  $660\mu f$  al conectar dos en paralelo.
- 2.- Conecte solamente la resistencia RL en su valor máximo 1KΩ.
- 3.-Conecte al osciloscopio solamente los puntos O y G. De la siguiente manera:
  - O a la entrada del canal A ó canal B.
  - G al común del osciloscopio.
- 4.- Ajuste los controles del osciloscopio para operar inicialmente en:

Modo de C.D.

2 o 5 V/div.

5 ms/div.

línea como fuente de disparo.

5.- Observe la forma de onda de la señal rectificada. Tome lectura del voltaje máximo.

Vm =

6.- Con el multimetro digital mida el voltaje de C.D. de salida.

VCD =

- 7.- Conecte un solo capacitor como filtro y efectúe las mediciones de voltaje de salida y de voltaje de rizo.
  - Vo -- Medirlo con multimetro digital volts de C.D.
  - Vr -- Medirlo en el osciloscopio en modo de C.A. en una escala adecuada.

RL	Vo	Vr	IL=Vo/RL
1000Ω			
900Ω	ALC: U		
800Ω			
700Ω			
600Ω		ACIÓ	A TOTAL
500Ω			
400Ω	Maria Santa da		
300Ω			
200Ω			
100Ω	4		

EXP102-4 FIME, Depto. Electrónica

- 8.- Conectar los dos capacitores electrolíticos en paralelo y observar que sucede en el voltaje de rizo. Al terminar desconecte el capacitor que agregó.
- 9.- Conecte al osciloscopio solamente los siguientes puntos de prueba:

A al canal A ó canal B.

B al común del osciloscopio.

10.- Observe y tome lectura del valor de la corriente de pico repetitiva con los diodos.

Figure 2. Simulación del rectificador de oudo completa.

RECTIFICADOR DE ONDA COMPLETA

\*Archivo RAPQ2 CIR
VEN 1 3 SIN(0,170,60)

RC 1 2 IM

RCNO3 0 M8G

LERC 4 5 0 015

KIRCAN LERG LECC 0.99

D1 4 6 DUN4448

D2 0 5 DIN4448

D3 6 4 DIN4448

LE DVODE LIB

LE DVODE LIB

TRAN 01M 35 34M

FROBE

END

OMA DE NUEVO LEÓN

DE BIBLIOTECAS

4 - Remover al unizo auterior para observar la comienta en la cu

Add-Trace IfRL)

EXP102-5 FIME, Depto. Electrónica

### VI.- SIMULACIÓN.

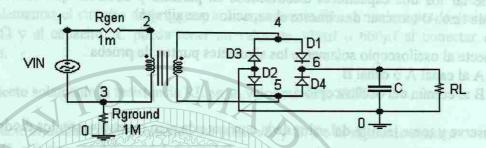


Figura 2. Simulación del rectificador de onda completa.

1.- Efectuar el análisis transitorio del circuito rectificador, considerando RL =  $100\Omega$  y C =  $330\mu$ f. Para ello escriba la siguiente información en el archivo EXP02.CIR.

CADOR	DE ONDA COMPLETA
EXP02.0	CIR
3	SIN(0,170,60)
2	1M
0	1MEG
3	1.5
5	0.015
LPI	RI LSEC 0.99
6	D1N4148
5	D1N4148
4	D1N4148
6	D1N4148
DE.LIB	
1M 33.3	3M /
	elo commultimetro dinital volta de C.D
	EXP02.0 3 5 LP:6 5 4 6 DE.LIB 1M 33.3

2.- Observar en el graficador de alta resolución las formas de onda de los voltajes en el primario y en el secundario.

Add-Trace V(2,3) V(4,5)

3.- Remover el trazo anterior para observar el voltaje de salida y de ser posible imprima la salida.

Add-Trace V(6)

4.- Remover el trazo anterior para observar la corriente en la carga.

Add-Trace I(RL)

EXP102-6 FIME, Depto. Electrónica 5.- Graficar la corriente en los diodos D1 y D4.

Add-Trace I(D1) I(D4)

MA DE NUEVO LEÓN

DE BIBLIOTECAS

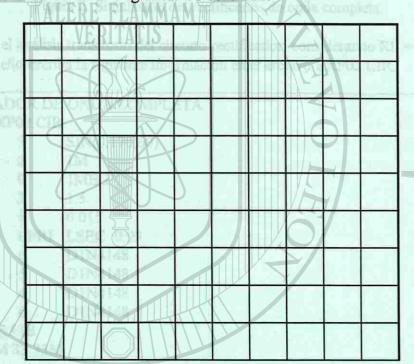
EXP102-7
FIME, Depto. Electrónica

#### VII.- REPORTE.

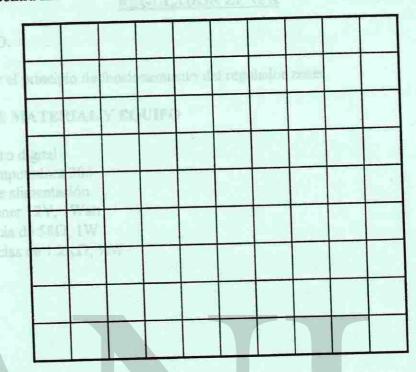
1.- En los pasos 5 y 6 mediste los valores de los voltajes de salida máximo y de C.D. Determine el valor teórico del voltaje de C.D.

 $VCD = 2Vm/\pi$ . VCD =

2.- Con los datos de la tabla obtenida en el punto 7 del procedimiento, obtener la curva de regulación de la fuente. Es decir graficar Vo contra IL.



3.- Similar al punto anterior obtenga la curva de rizo de la fuente no regulada. Para ello graficar Vr contra IL.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

li-Rimover di traza tanterio: pura observur la commente en la carg

EXP102-8 FIME, Depto. Electrónica

EXP102-9 FIME, Depto. Electrónica

EXP103

### REGULADOR ZENER

### I.- OBJETIVO.

☐ Comprobar el principio de funcionamiento del regulador zener.

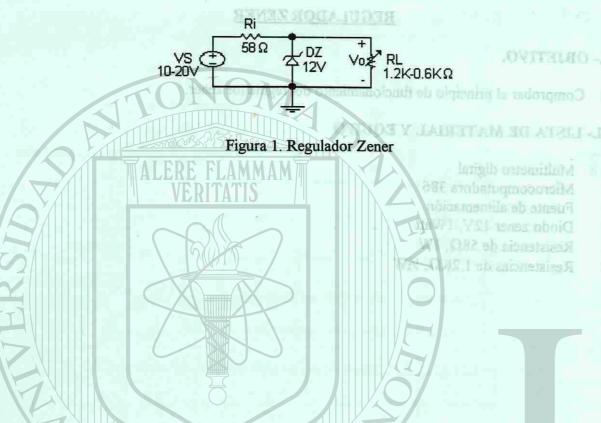
### II.- LISTA DE MATERIAL Y EQUIPO

- 1 Multimetro digital
- 1 Microcomputadora 386
- 1 Fuente de alimentación
- 1 Diodo zener 12V, 1Watt
- 1 Resistencia de 58Ω, 1W
- 2 Resistencias de 1.2KΩ, ½W

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN
DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

EXP103-1 FIME, Depto. de Electrónica

### III.- CIRCUITO DEL EXPERIMENTO.



### IV.- TEORIA PRELIMINAR.

Se diseño el circuito regulador zener de la figura 1 bajo las siguientes condiciones:

- a) La corriente en la carga varia de 10 a 20 mA.
- b) El voltaje de la fuente VS varia de 10 a 20V.

Si consideramos constante el valor de la resistencia de carga es factible medir el porciento de regulación de la siguiente forma:

% Reg = (Vomax - Vomin)/Vonominal.

en donde Vonominal es igual a 12 Volts.

DA C 2 TRUENER — mino Air DE LO DE PER NEVEL O. 7. RV = 12. NS=0) — kama par NS CARI — mino de regolación para RC = 0.6K, para cato en el amilicador de abración agracar el trazo.

Add-Timos V(2)

### UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

EXP103-2 FIME, Depto. de Electrónica EXP103-3 FIME, Depto. de Electrónica

### V.- PROCEDIMIENTO:

1.- Implemente el circuito de la figura 1. Ajuste VS = 10V y RL =  $0.6K\Omega$  (dos resistencia de 1.2K en paralelo).

2.- Tome lectura del voltaje de salida mínimo Vomin, utilizando el multimetro digital en Volts de C.D.

Vomin =

3.- Ajuste para obtener:  $VS = 20V y RL = 0.6K\Omega$ .

4.- Tome lectura del voltaje de salida máximo Vomax, usando el multimetro digital en volts de C.D.

Vomax =

5.- Repita los pasosdel 1 al 4 con un valor de RL igual a 1.2KΩ.

Vomin = \_\_\_\_ Vomax =

### UNIVERSIDAD AUTÓNO

### DIRECCIÓN GENERA

VI.- SIMULACION.

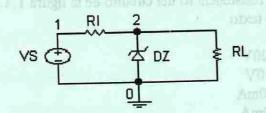
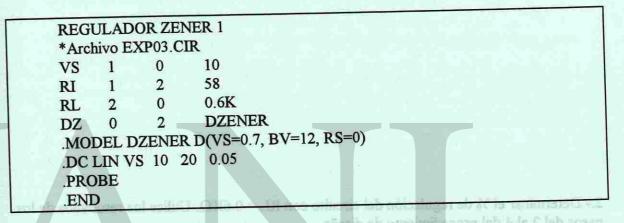


Figura 2. Regulador Zener

1.- Crear el archivo EXP03.CIR con la informacion del circuito de la figura 2.



2.-Obtener la curva de regulación para RL = 0.6K, para esto en el graficador de alta resolución agregar el trazo.

Determine:
Vomin = \_\_\_\_\_
Vomax = \_\_\_\_\_

3.- Remover el trazo y graficar la corriente I(RI), I(DZ), I(RL) en función de VS.

Add-Trace I(RI) I(DZ) I(RL)

4.- Repetir los pasos del 1 al 2 modificando el valor de la resistencia de carga RL a 1.2K.

Vomin = TECAS

### VII.- REPORTE.

1.- Calcular el valor de la resistencia Ri del circuito de la figura 1. Considere el circuito de diseño visto en el libro de texto.

Datos:

VSmax = 20V

VSmin = 10V

ILmax = 20mA

ILmin = 10mA

Vz = 12V

2.- Determinar el % de regulación del circuito con RL = 0.6KΩ. Utilice los resultados de los pasos del 2 al 4 del procedimiento de diseño.

ver al mazo y graficar la corriente I(RI), I(DZ), I(RL) en función de VS.

4.- Repetir los pasos del 1 al 2 modificando el valor de la resistencia de carga RL a 1 2K

4.- Determine el % de regulación del circuito con RL =  $0.6~\mathrm{K}\Omega$ . Use los resultados obtenidos en el punto 2 de la simulación.

IL- LISTA DE MATERIAL Y EQUIPO.

Osciloscopio

Microcomputadora 38

Puente de alimentralea

Generador de himbon

Petenciónistro lingui de 116

Dinado IN91

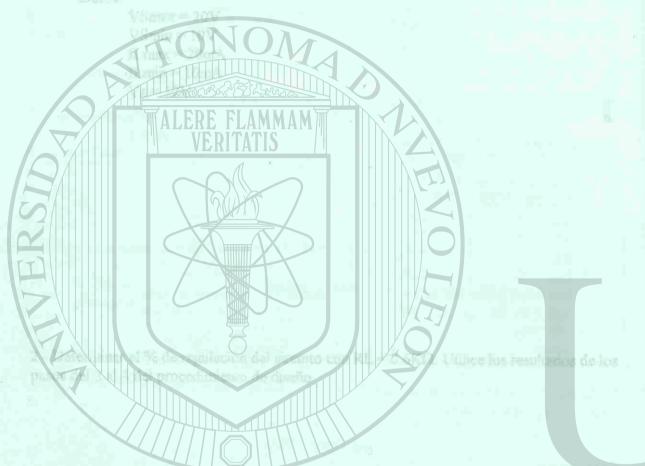
3.- Determinar el % de regulación del circuito con RL =  $1.2K\Omega$ . Use los resultados obtenidos en el punto 5 del procedimiento de diseño.

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

resolución agregar el trazo,

EXP103-6 FIME, Depto. de Electrónica EXP103-7 FIME, Depto. de Electrónica la Calcular al valor de la resimencia de del mienero de la figura. L. Considere el circulto de

Day



EXP104 TABLES DE LA COMPANIO - AL

### CIRCUITO RECORTADOR

#### I.- OBJETIVO.

☐ Comprobar el funcionamiento de un circuito recortador.

### II.- LISTA DE MATERIAL Y EQUIPO.

- 1 Osciloscopio
- Microcomputadora 386
- 1 Fuente de alimentación
- 1 Generador de funciones
- 1 Potenciómetro lineal de 1KΩ
- 1 Diodo 1N914

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

EXP104-1 FIME, Depto. de Electronica.

### III.- CIRCUITO DEL EXPERIMENTO.

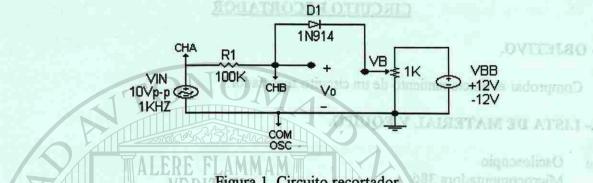


Figura 1. Circuito recortador.

### IV.- TEORIA PRELIMINAR.

En el circuito recortador serie de la figura 1, el diodo únicamente conduce cuando la señal de entrada Vin excede al voltaje de referencia VB. De tal manera que el comportamiento del circuito se puede resumir de la siguiente manera

respectivamente. Use la marma escala de defleción terrical en ambosicanales

Vo = Vi	para	Vi < VB
Vo = VB	para	Vi > VB

lo anterior considerando que el diodo es ideal.

# UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

EXP104-2 FIME, Depto. de Electronica.

EXP104-3 FIME, Depto. de Electrónica

### VI.- SIMULACION. The view of the state of th

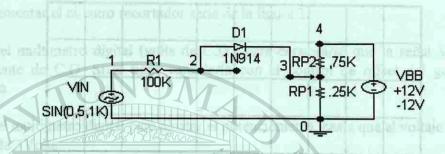


Figura 2. Circuito recortador serie.

1.- Crear el archivo EXP04.CIR con la información del circuito recortador serie de la figura

		-	1	CIRCUITO RECORTADOR 1
			XP04.C	IR TE ORIGINAL
	VIN R1	1	0 2	SIN(0 5 1K) 100K
12	RP1 RP2	3	0	0.25K 0.75K
	D1	2	3	D1N4148
	VBB .LIB I	EVAI		DC 12
	.TRA		m 2m	
- 1	.END			

2.- En el graficador de alta resolución observar caso por caso las formas de onda de los voltajes de entrada y de salida.

Add-Trace V(1) V(2)

3.- Imprimir la gráfica del primer caso con el diodo y la fuente en posición original

#### VII.-REPORTE

1.-Explicar el funcionamiento del circuito recortador serie de la figura 1.

2.-Explique el comportamiento de del circuito de figura 1, si el potenciómetro se ajusta para VB=0.

3.-Explique el comportamiento del circuito de la figura 1, cuando la fuente VBB es igual a - 12 V.(Paso 6 del procedimiento).

4.-En el circuito de la figura 2, porqué se asignaron los valores de RP1=0.25K y RP2=0.75K.

MA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

EXP104-6 FIME, Depto. de Electronica. EXP104-7 FIME, Depto. de Electronica.

### III.-CIRCUITO DEL EXPERIMENTO.

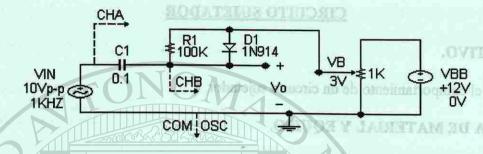


Figura 1. Circuito Sujetador.

### IV.-TEORIA PRELIMINAR.

Existen dos formas de agregar una componente de CD a una señal de entrada de CA.

V.PROCEDIMIENTO.

- Agregando una fuente de voltaje de CD en serie.
- Agregando un circuito sujetador (Capacitor, Resistencia y Diodo).

En el circuito de la figura 1, durante el semiciclo negativo de la señal de entrada, el capacitor se carga hasta un voltaje igual a Vm-VB.

Durante el semiciclo positivo la constante de tiempo RLC>>T/2 (T=período) no permite que el capacitor se descarge y el diodo no conduce, por lo que:

 $V_0=V_i+V_m-V_B$ 

Esta última ecuación es la expresión del voltaje de salida para todo el tiempo.

### UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

### DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

EXP105--2 FIME, Depto. de Electrónica EXP105--3
FIME, Depto. de Electrónica

### V.-PROCEDIMIENTO.

- 1.-Implementar el circuito sujetador de la figura 1. mus anno sujetador de la figura 1.
- 2.-Use el multímetro digital (Volts de CD) para cerciorarse que la señal de entrada Vin no tiene componente de CD. Si la tiene cancelarla con control de offset del generador de funciones.

IV-TEORIA PRELIMINAR.

- 3.-Use el multímetro digital para ajustar el potenciómetro, hasta que el voltaje de CD en VB sea de 3 volts.
- 4.-Observe en el osciloscopio en modo de CD, las señales de entrada y de salida respectivamente. Use la misma escala de deflexión vertical en ambos canales.
- 5.-Dibuje la forma de onda de los voltajes Vin y Vo.

### ERSIDAD AUT DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

EXP105--4 FIME, Depto. de Electrónica

### VI.-SIMULACION.

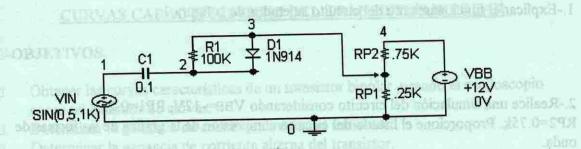


Figura 1. Circuito Sujetador.

1.-Crear el archivo EXP05.CIR con la información del circuito sujetador de la figura 2.

CIRCU	ITO SU	JJET	ADOR	. "			
*Archiv	o EXP	05.C	IR + 1 Ampe				
VIN	1	0	SIN(0,5,	1K)			
C1	1	2	0.1UF				1
R1	2	3	100K				
RP1	3	0	0.25K				
RP2	4	3	0.75K	Am 0251 A			
D1	3	2	D1N914				
VBB	4	0	DC	0			
	IODE.	LIB					
0 0	10.001N		5M	UIC			
PROE							
END	=1				 1 1		
.17111							

2.-En el graficador de alta resolución observar los voltajes de entrada y de salida.

Add Trace V(1) V(2)

- 3.-Imprimir la gráfica anterior.
- 4.-Repetir los pasos 1,2 y 3, modificando el vaolr de la fuente VBB a 0 volts.

EXP105--5 FIME, Depto. de Electrónica 1.-Explicar el funcionamiento del circuito sujetador de la figura 1.

2.-Realice una simulación del circuito considerando VBB=-12V, RP1=0.25K y RP2=0.75k. Proporcione el listado del circuito e impresión de la gráfica de las formas de onda.

EXP106

### CURVAS CARACTERISTICAS DEL TRANSISTOR BIPOLAR

### I.-OBJETIVOS.

- Obtener las curvas características de un transistor bipolar ,usando el osciloscopio como un trazador de curvas.
- Determinar la ganancia de corriente directa del transistor.
- Determinar la ganancia de corriente alterna del transistor.

### II.-LISTA DE MATERIAL Y EQUIPO. que se asset para la duffección vertical del haz de electrones en chomprissencia. El

- Osciloscopio della estata della
- Microcomputadora 386
- Multimetro digital
- Fuente de alimentación
- Puente rectificador 1 Ampere, 50 V
- Transistor 2N3904
- Resistencia 100KΩ, ½W
- Resistencia 100Ω, ½W
- Resistencia de 3.3KΩ, ½W
- Transformador 120/12 VCA, 250 mA

## 4.-Repetit los pasos 1,2 y 3 , modificando el vaoir de la fuente VBB a U volta

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

EXP105--6 FIME, Depto. de Electrónica

EXP106-1 FIME, Depto. de Electrónica.

### III.-CIRCUITO DEL EXPERIMENTO.

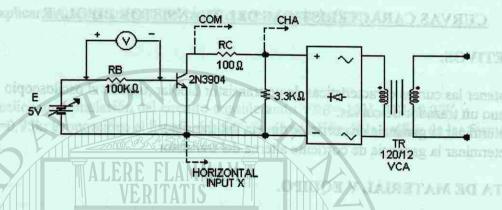


Figura 1. Circuito para obtener curvas características del transistor.

### IV.-TEORIA PRELIMINAR.

Las curvas características del transistor, es un conjunto de curvas, que representan la variación de la corriente de colector iC con respecto al voltaje entre colector y emisor VCE, para un valor constante de la corriente de base iB.

V-PROCEDIMIENTO.

El circuito de la figura 1, permite por el lado del circuito base-emisor, ajustar el valor de la corriente de base. Por ejemplo, si la fuente E se ajusta de tal modo que la caída en RB sea de 2V, entonces la corriente de base es de 20µA.

Por el lado del circuito colector-emisor, se aplica una señal rectificada de onda completa. La caída de voltaje en la resistencia del colector RC, es proporcional a la corriente de colector iC, por lo que se usará para la deflexión vertical del haz de electrones en el osciloscopio. El voltaje entre colector y emisor VCE con signo negativo se aplicará a la entrada horizontal del osciloscopio operando en modo XY.

De la forma anterior es posible obtener una curva característica del transistor y sólo es cuestión de ajustar de nuevo la corriente de base para observar un nuevo trazo.

### UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON

### DIRECCIÓN GENERA

E BIBLA GIAD

ara cambiar al voltajo en RB, ajuato al valor do la facuto de slimentación E y rai

EXP106-2 FIME, Depto. de Electrónica.

EXP106-3 FIME, Depto. de Electrónica.

### V.-PROCEDIMIENTO.

- 1.-Implementar el circuito de la figura 1.
- 2.-Con el multímetro digital mida la caída en RB y ajuste la fuente de alimentación para obtener una caída de voltaje igual a 2 volts.

IV-TEORIA PRELIMINAR.

3.-Ajuste los controles del osciloscopio de la siguiente forma:

Acoplamiento de CD

500 mv/div

Modo XY

Atenuación horizontal 1:10

Vernier en posición de calibración

- 4.-Observe lo siguiente:
- Se forma una curva característica del transistor.
- La deflexión vertical es provocada por la caída en RC.

$$i_C = \frac{V_{RC}}{R_C}$$

- La deflexión horizontal es provocada por el voltaje entre colector y emisor VCE y es negativa.
- La escala horizontal es 10v/div.
- La corriente de base está determinada por la caída de voltaje en RB.

$$i_B = \frac{V_{RB}}{R_B}$$

- 5.-Ajuste el vernier de calibración de ganancia horizontal hasta tener un desplazamiento horizontal igual
- a 4 veces el actual.

El resultado de esto es un escala horizontal de 2.5V/div.

En este paso utilice los controles los controles de posición vertical y horizontal, para hacer que el origen de la curva esté cerca de la esquina inferior derecha de la pantalla del osciloscopio.

6.-Dibuje una familia de curvas características para los siguientes valores de caída de voltaje en RB. La

curva se observa en el osciloscopio y se debe dibujar en la cuadrícula.

VRB	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	V
iB	20	40	60	80	100	120	140	160	180	200	μА

Para cambiar el voltaje en RB, ajuste el valor de la fuente de alimentación E y mida solamente la caída

EXP106-4 FIME, Depto. de Electrónica. de voltaje con el multímetro digital.

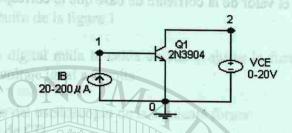
Etiquete a cada curva con el valor de la corriente de base que le corresponde.

MA DE NUEVO LEÓN

DE BIBLIOTECAS

EXP106-5
FIME, Depto. de Electrónica.

#### VI.-SIMULACION.



de voltaje con el maltimetro digital.

Figura 1. Circuito para obtener curvas características del transistor.

1.-Crear el archivo EXP06.CIR con la descripción del circuito de la figura 1.

CURVAS CA	RACTERIST	CAS DEL	FRANSIST	OR BIPO	LAR		
*Archivo EXI			7   1				
VCE 2	ALL OCHEN CHEC	() (7 to )	a transistor		$\sim$		
IB 0	ion representation	OVA	ros la caida	3.55an			
Q1 2	1 \	Q2N	J3904				
LIB BIPOLA	R.LIB	Name of the last	A. A.				
DC VCE	0 / 2	0 0.1	IB II	20VA	200VA	20VA	
.PROBE	arter lime investor		dh mer ak a				When in
.END	The same of the sa		상반 문학에 무취 기		s Threatist	L. richtmon	ART A G

2.-En el graficador de alta resolución observar la familia de curvas características del transistor.

Add Trace IC(Q1)

3.-Agregar el trazo de una línea de carga de CD, con los siguientes datos  $VCC=15,RC=1K\Omega$ , RE=0.5K

Add Trace (15-VCE)/1.5K

4.-Imprimir la gráfica.

VII.-REPORTE.

1.-Determine el valor de la ganancia de corriente directa (βF) del transistor para el punto de operación

dado por:

IBQ=60µA

VCEQ=10V

Emplear la familia de curvas obtenidas en el paso 6 del procedimiento.

2.-Determine el valor de la ganancia de corriente alterna (β) del transistor para el siguiente punto de

operación:

IBQ=60μA

VCEO=10V

Para ello determine de la misma familia de curvas:

iC2=\_\_\_\_\_ para iB2=80μA

iC1= para  $iB1=40\mu A$ 

β=

3.-Con la gráfica impresa en el paso #4 de la simulación, determine los valores de las ganancias de CD y

CA del transistor para VCEQ=10V, IBQ=60µA.

Alternativamente, puede hacer uso de las facilidades del graficador de alta resolución.

MA DE NUEVO LEÓN

DE BIBLIOTECAS

EXP106-6 FIME, Depto. de Electrónica.

EXP106-7 FIME, Depto. de Electrónica.

### CIRCUITO DE POLARIZACION EMISOR-COMUN

### I.- OBJETIVO.

Diseñar la red de polarización de un amplificador EC, medir el punto de operación, determinar la máxima oscilación del voltaje de salida y medir la ganancia de voltaje.

### II.- LISTA DE MATERIAL Y EQUIPO.

- Osciloscopio
- 1 Microcomputadora
- 1 Fuente de poder
- 1 Generador de funciones
- Transistor 2N3904
- 1 Resistencia de 15KΩ, ½W
- 1 Resistencia 120KΩ, ½W
- 2 Resistencias 10KΩ, ½W
- 1 Resistencia 1KΩ, ½W
- 1 Resistencia 220Ω, ½W
- 2 Capacitores de 47μF, 50v
- Capacitor 100μF, 50v

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL

STREET, SACRON, GERNINGS.

L-Détermine el valor de la garancia de cogricme directa (\$8) del transistor para el punto

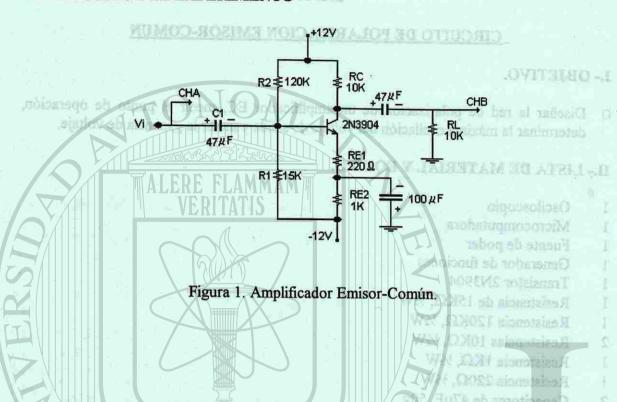
DE BIBLIOTECAS

VEE - 100 RCI

R) = (3-7280). peleccionar 1: R2 = (1080), seleccionar 12080.

EXP107-1 FIME, Depto de Electrónica.

### III.- CIRCUITO DEL EXPERIMENTO



# UNIVERSIDAD AUTÓNO DIRECCIÓN GENERA

EXP107-2 FIME, Depto de Electrónica.

#### IV.- TEORIA PRELIMINAR:

RE = RE1 + RE2

Se procederá a reparar el diseño del circuito de polarización del amplificador EC mostrado en la figura 1. Se seguirá el procedimiento de diseño sugerido en el libro de texto, pero modificado para el caso de dos fuentes de alimentación.

RCD = RC + RE

Los datos para el diseño son:

$$VCC = 12V$$

$$VEE = -12V$$

$$RC = 10KΩ$$

$$RL = 10KΩ$$

$$RE1 = 220Ω$$

$$RE2 = 1KΩ$$

$$BJT = 2N3904$$

$$βF = 100$$

PASO 1.- Determinar ICQ para máxima oscilación simétrica.

RE = 1.22 K
$$\Omega$$
 RCD = 11.22K $\Omega$   
RCA = RE1 + (RC\*RL)/(RC + RL)  
RCA = 5.22K $\Omega$   

$$ICQ = \frac{VCC - VEC}{RCA + RCD} = 1.46\text{mA}$$

PASO 2.- Determinar el valor de VCEQ.

PASO 3.- Seleccionar RB.

$$RB = \beta RE / 10$$

$$RB = 12.2K\Omega.$$

PASO 4.- Determinar el voltaje de Thevenin VBB

VBB = 
$$(ICQ*RB)/\beta + VBE + ICQ*RE + VEE$$
  
VBB = -9.34V

PASO 5.- Encontrar los valores de R1 y R2.

$$R1 = 13.72K\Omega$$
 selectionar  $15K\Omega$   
 $R2 = 110K\Omega$  selectionar  $120K\Omega$ .

EXP107-3 FIME, Depto de Electrónica. PASO 6.- Determinar el voltaje máximo de salida.

OF TO VCEM = VCEQ lossificing to observe 4th offerile is arrange a fusionous of

VCEM = Voltaje máximo entre colector-emisor.

VLM = Voltaje máximo en la carga. Il sis lestacult and altream obsorbibem oraqui

VLM = VCEM[(RC\*RL)/(RC+RL)]/[RE1 + (RC\*RL)/(RC + RL)] VLM = 7.3 V.

ALERE FLAMMAM
VERITATION as advantaged and of the property of

UNIVERSIDADAUTÓN

DIRECCION GENERA

 $\Omega = 13.738\Omega$  selections 158 $\Omega$ 

IV. TEORIA PRELIMBVAR:

EXP107-4 FIME, Depto de Electrónica.

### V.- PROCEDIMIENTO. PROCEDIMIENTO.

- 1.- Implementar el circuito mostrado en la figura 1. Observe que los valores corresponden a los resultados del diseño realizado en la teoría preliminar.
- 2.- Medir el punto de operación con la ayuda del multimetro digital. Tome lectura de los siguientes voltajes (todos son con respecto a tierra). Use escalas adecuadas.

VCC = \_\_\_\_\_ VEE = \_\_\_\_ VC = \_\_\_\_ VB = \_\_\_\_ VE = \_\_\_\_

3.- Una forma de saber si el circuito está funcionando bien es tomar en cuenta lo siguiente:

El voltaje de la base VB debe de ser aproximadamente 0.7V mayor que el voltaje del emisor VE

El voltaje del colector VC debe de ser mayor que el voltaje de la base VB.

El voltaje del colector VC es mayor que el voltaje del emisor VE.

El voltaje del colector VC debe de ser menor que el voltaje de alimentación VCC.

Si lo anterior no se cumple revisar las conexiones del circuito, checar el transistor y repetir los pasos 2 y 3.

- 4.- Aplique en la entrada del amplificador una señal senoidal de 5KHz y 200mV aproximadamente. Observe en el osciloscopio las señales de entrada y salida simultáneamente.
- 5.- Tomar lectura de las amplitudes de los voltajes de entrada y de salida.

V<sub>0</sub> = \_\_\_\_\_

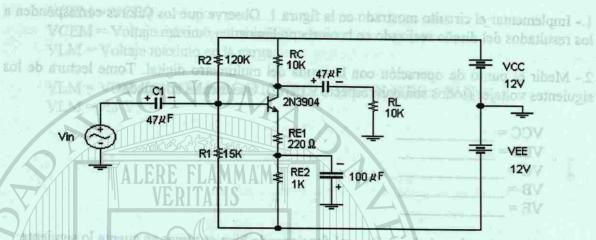
\*Observe que la señal de salida está invertida con respecto a la señal de entrada.

LIB PIPOLARLIB

- 6.- Incremente la amplitud de la señal de entrada hasta observar que la salida empieza a distorsionarse.
- 7.- Tomar lectura de la máxima oscilación del voltaje de salida.

VLM = Vp

EXP107-5 FIME, Depto de Electrónica.



V. PROCEDDINGSTO.

Figura 1. Amplificador Emisor Común.

1.- Crear el archivo EXP07.CIR con la información del amplificador emisor-común de la figura 1.

AMPLIFICADOR EMISOR-COMUN VIN 1 0 SIN(0, .1, 5K) VCC 3 0 12V VEE 0 4 12V 1 2 47uF .. Anlinua en la entreda d 2 4 15K unoximaluname. Observe en 2 3 120K 5 2 6 Q2N3904 RC 3 5 10K RE1 6 7 220 RE2 7 4 1K CE 0 7 100uF C2 8 5 47uF RL 8 0 10K LIB BIPOLAR LIB .TRAN .1m .5mS .005mS

2.- Observar en el graficador de alta resolución, la forma de onda de los voltajes de entrada y de salida.

Add-Trace 10\*V(1) V(8)

3.- Use las facilidades del graficador para medir la amplitud del voltaje de salida.

Vo=

EXP107-6 FIME, Depto de Electrónica. 4.- Editar el archivo para modificar la amplitud de Vin a 0.32 o un valor cercano con el propósito de determinar la máxima oscilación posible del voltaje de salida. Repita los pasos 2 y 3.

1.~ OB.Vo = 108

2. Explique el porqué de la pequeda ditarencia entre la ICQ de diseño y la ICQ1

3. Explique el porqué de la pequeda ditarencia entre la ICQ de diseño y la ICQ1

3. Explique La Arx La Arxilla V. Explique La Arxilla Arxilla De La Arxilla De

1 Listandorgali

-Con las mediciones calizadas en el paso 5 del procedimiente, determine la granneia del capitificador;

1 Registenen de 21/03, 569

2 Resistancias (GICC), VIW

4.- Effective una comparación entre el valor teúnico y práctico (fg) voltaje právinty sin satidar. Revise la sección de teoria prelimient y el resultado del 1750 7 de procedurate de 1851.

Capacition Worth, 50V

5.- Determine la guancia de voltaje con les resultados elterádos en los paros 2 y 3 de la

Compare los valores tabrico y práctico de la simulación del voltaje minámo de oscilación

MA DE NUEVO LEÓN

DE BIBLIOTECAS

EXP107-7
FIME, Depto de Electrónica.

ICQ = \_\_\_\_\_ VCEQ =

2.- Explique el porqué de la pequeña diferencia entre la ICQ de diseño y la ICQ:

3.-Con las mediciones realizadas en el paso 5 del procedimiento, determine la ganancia del amplificador:

4.- Efectúe una comparación entre el valor teórico y práctico del voltaje máximo de salida. Revise la sección de teoría preliminar y el resultado del paso 7 del procedimiento.

5.- Determine la ganancia de voltaje con los resultados obtenidos en los pasos 2 y 3 de la simulación.

6.- Compare los valores teórico y práctico de la simulación del voltaje máximo de oscilación en la salida.

III. CHRCUITO DEL EXPERIMENT (8019XX)

### DISEÑO DE UN AMPLIFICADOR EMISOR COMUN

### I.- OBJETIVOS.

Diseñar un amplificador EC; medir los parámetros de funcionamiento del amplificador.

### II.- LISTA DE MATERIAL Y EQUIPO.

- 1 Osciloscopio
- 1 Microcomputadora 386
- Fuente de poder
- Generador de funciones
- 1 Transistor 2N3904
- 1 Resistencia de 22KΩ, ½W
- 1 Resistencia 120KΩ, ½W
- 2 Resistencias 10KΩ, ½W
- 1 Resistencia 1.2KΩ, ½W
- Resistencia 330Ω, ½W
- 2 Capacitores de 47μf, 50V

O'S. VIJE VID ROO, REY KEL

1 Capacitor 100μf, 50V

MADE NUEVO LEÓN

NERAL DE BIBLIOTECAS

1020125025

EXP108-1 FIME, Depto. de Electrónica.

### III.- CIRCUITO DEL EXPERIMENTO.

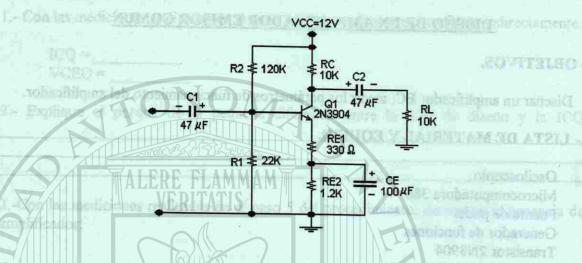


Figura 1. Amplificador Emisor-Común.

# UNIVERSIDAD AUTÓNO DIRECCIÓN GENERAI

EXP108-2 FIME, Depto. de Electrónica.

### IV.- TEORIA PRELIMINAR.

Se efectuará el diseño de un amplificador EC, con las siguientes características:

Av = -20

PASO 2.« Se detemplies la resistancia de entrada: VCC = 12V

 $Ro > = 8K\Omega$ 

BJT = 2N3904 (EXA + all + EX) (EXE + all)\*(EX = 12.

 $RL = 10K\Omega$ 

 $\beta = 100$ 

Máxima oscilación simétrica.

PASO 1.- Seleccionar el valor de la resistencia del colector RC

RC > = Ro

 $RC = 10K\Omega$ 

PASO 2.- Establecer ecuaciones de diseño:

Av = -[RC\*RL]/[(RC + RL)(RE1 + Rib)]

ICQ = VCC/(RCA + RCD)

RE = VCC/(10\*ICQ)

Rib = 0.026/ICQ

R2= VCC\*RB/VBB

RE = RE1 + RE2

Sustituyendo los valores conocidos en las primeras tres ecuaciones se obtiene:

20 = 5/[RE1 + .026/ICQ]

ICO = 12/[5 + RE1 + 10 + RE]

RE = 1.2/ICQ

PASO 3.- Valores de ICQ, RE Y RE1

Se determinan resolviendo las ultimas tres ecuaciones del paso anterior:

ICQ = 0.699mA

 $RE = 1.72K\Omega$ 

RE1 = 0.363 KΩ

Seleccionar 330Ω

 $RE2 = 1.72 - .363 = 1.357K\Omega$ 

Seleccionar 1.2KΩ

senoidal de 5KHr y ZhimYp-p

PASO 4.- Calcular RB

 $RB = \beta RE/10$ 

 $RB = 17.2K\Omega$ 

PASO 5.- Calcular el voltaje de Thevenin VBB

 $VBB = ICQ*RB/\beta + VBE + ICQRE$ 

VBB = 1.82V

PASO 6.- Calcular las resistencias R1 Y R2

R1 = VCC\*RB/(VCC - VBB)

 $R1 = 20.27K\Omega$ 

Seleccionar 22KΩ

EXP108-3
FIME, Depto. de Electrónica.

R2 = VCC\*RB/VBB

 $R2 = 113.4K\Omega$ .

Seleccionar 120KΩ

IV. TEORIA PRELIMINAR.

THE WINDOWARDS

= F(RE) +:02

10 = 12/IS + KEL+

RI = VOC\*RB/(VCC - VBB)

PASO 7.- Se determina la resistencia de entrada:

 $Ri = RB*(hie+\beta RE)/(RB + hie + \beta RE)$ 

 $Ri = 15.6K\Omega$ 

UNIVERSIDAD AUTÓN

DIRECCIÓN GENERA

EXP108-4
FIME, Depto. de Electrónica.

### V.- PROCEDIMIENTO.

- 1.- Implementar el circuito del amplificador EC de la figura 1. Observe que los valores corresp onden al diseño planteado en la teoría preliminar.
- 2.- Medir el punto de operación, tomando lectura de los siguientes voltajes de CD con el multimetro digital:

VCC = \_\_\_\_\_ VC = \_\_\_\_ VB = \_\_\_\_ VE = \_\_\_\_

3.- Observe que se cumplan los siguientes requisitos:

 $VB \approx VE + 0.6$  VC > VB VC > VEVC < VCC

Si no se cumplen estas condiciones, revisar las conexiones, checar el transistor y analizar los pasos del 1 al 3 nuevamente.

- 4.- Aplique en la entrada del amplificador una señal senoidal de 5KHz y 200mVp-p aproximadamente. Observe en el osciloscopio las señales de entrada y de salida simultaneamente.
- 5.- Tomar lectura de las amplitudes de los voltajes de entrada y de salida.

\*Observe que la señal de salida, esta invertida con respecto a la señal de

6.-Para medir el valor de la resistencia de entrada del amplificador, inserte una resistencia de  $10K\Omega$  entre los puntos A y B.

Tome lectura con el osciloscopio de los siguientes voltajes (alternativamente puede utilizar el multimetro digital en voltaje de C.A.):

VA = VB =

entrada.

El valor de Ri se puede determinar sabiendo que

VB = VA\*Ri/(10K + Ri)

Al terminar retire del circuito la resistencia de  $10 \mathrm{K}\Omega$ .

EXP108-5 FIME, Depto. de Electrónica. 7.- Para medir la resistencia de salida del amplificador, tome nota de los siguientes voltajes de C.A.

V. PROCEDIMIENTO,

Con la carga  $RL = 10K\Omega$  conectada. Umilian il met al no obsemble official la nabino

Con una carga  $RL' = 5K\Omega$  (use dos de  $10K\Omega$  en paralelo) Vo' =

La resistencia de salida se puede determinar de la siguiente relación:

$$\frac{Vo}{Vo'} = \frac{RL}{RL'} \left( \frac{Ro + RL'}{Ro + RL} \right)$$

JANUERSIDAD AUT CAMPA

The single-service of the state of

DIRECCIÓN GENERA

Al terminar ceire del circuito la resistencia de 10KO

EXP108-6 FIME, Depto. de Electrónica.

### VI.- SIMULACION

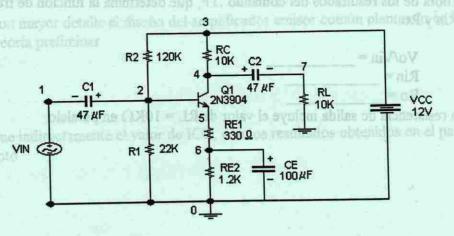


Figura 2. Amplificador Emisor-Común.

1.- Crear el archivo EXP08.CIR con la información del circuito amplificador EC de la figura 2.

					COMUN
	*Archi	vo E	XP08.CI	2	
	VIN	1	0	AC	relación planteada. Calcule in runatouna de ontrasa
Though	VCC	3	0	DC	12
	C1	2	1	47UF	
	C2	4	7	47UF	
	CE	6	0	100U	F
	R1	2	0	22K	ela de setiria, con los resultados obsenidos en el pala 7
A IP	R2	3	2	120K	selfa plunten v
	RC	3	4	10K	Breide piscovers.
	RE1	5	6	330	
	RE2	6	0	1.2K	
	RL	7	0	10K	
	Q1	4	2	5	Q2N3904
1	LIB 1	BIPO	LAR.LIE		
	.TF V	7(7) N	/IN	1-1	
10	END	)			

- 2.- Los resultados de la simulación se pueden observar en el archivo de salida EXP08.OUT, para ello vea la opción FILE, BROWSE
- 3.- Tome nota de los voltajes del punto de operación:

VC = \_\_\_\_\_ VB = \_\_\_\_

EXP108-7
FIME, Depto. de Electrónica.

Mr. SIMULACION 4.- Tome nota de los resultados del comando .TF, que determina la función de transferencia Vo/Vin, Rin y Ro. Vo/Vin = Rin = Ro= La resistencia de salida incluye el valor de RL =  $10K\Omega$  en paralelo.

> EXP108-8 FIME, Depto. de Electrónica.

### VII.- REPORTE.

IL-LISTA DE MATERIAL Y EQUIPO.

Translator 2N5931

1.- Repita con mayor detalle el diseño del amplificador emisor común planteado en la sección de teoría preliminar.

2.- Determine indirectamente el valor de ICQ, con los resultados obtenidos en el paso 2 del

3.- Determine el valor de la ganancia de voltaje del amplificador, haciendo uso de los resultados obtenidos en el paso 5 del procedimiento.

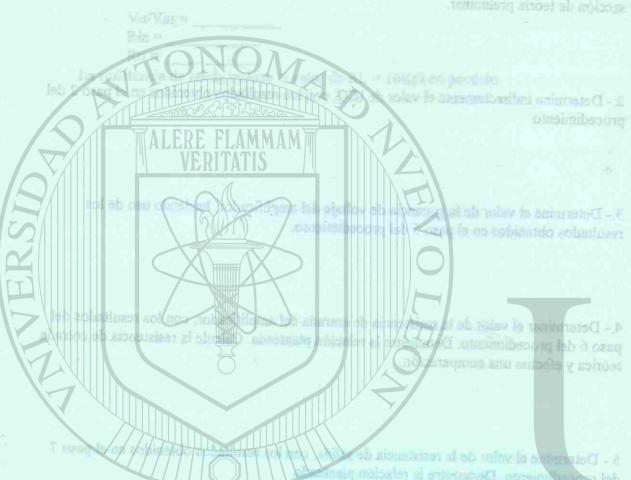
4.- Determinar el valor de la resistencia de entrada del amplificador, con los resultados del paso 6 del procedimiento. Demuestre la relación planteada. Calcule la resistencia de entrada teórica y efectue una comparación.

5.- Determine el valor de la resistencia de salida, con los resultados obtenidos en el paso 7 del procedimiento. Demuestre la relación planteada.

6.- Con los resultados obtenidos en el paso 3 de la simulación, determine el valor de ICQ.

7.- Determine el valor de la resistencia de salida del amplificador, tomando como base la Ro obtenida en el paso 4 de la simulación.

EXP108-9 FIME, Depto. de Electrónica. sección de teoria preiminar.



EXP109 TV ANTHER MET AND CHILDREN - HE

### CURVAS CARACTERISTICAS DEL FET

### I.- OBJETIVOS.

- Obtener las curvas características del transistor de efecto de campo, usando el osciloscopio como un trazador de curvas.
- Determinar la transconductancia del FET.

### II.- LISTA DE MATERIAL Y EQUIPO. casida de voltaja en la Ventrencia del drenedos. RD., os proporcional a la

- Osciloscopio ades un por lo mae es usurá para la defleción vertical del har de electrones.
- Microcomputadora 386
- Multimetro digital
- Fuente de alimentación
- Puente rectificador 1 Ampere,
- Transistor 2N5951
- Resistencia 100Ω, ½W
- Resistencia 3.3KΩ, ½W
- Transformador 120/12 VCA

### NIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

# DIRECCION GENERAL DE BIBLIOTECAS

EXP109-1 FIME, Depto de Electrónica.

### III.- CIRCUITO DEL EXPERIMENTO.

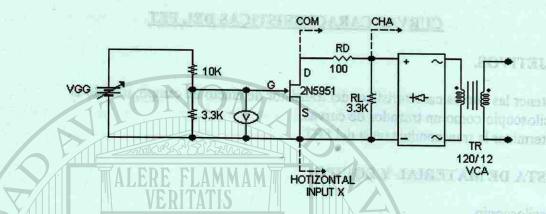


Figura 1. Determinación de las curvas características del FET.

### IV.- TEORIA PRELIMINAR.

Las curvas características del FET, son un conjunto de curvas que describen el comportamiento de la corriente de salida iD, con respecto al voltaje de salida VDS, para distintos valores de voltaje de entrada VGS.

El circuito de la figura 1, permite por el lado del circuito compuerta-surtidor, ajustar el valor del voltaje VGS. Por ejemplo VGS = 0 si la fuente E esta desconectada, ó bien VGS puede tomar un valor negativo como -0.5V si el valor de E se ajusta convenientemente.

Por el lado del circuito drenador-surtidor, se aplica una señal rectificada de onda completa. La caída de voltaje en la resistencia del drenador RD, es proporcional a la corriente del drenador iD, por lo que se usará para la deflexión vertical del haz de electrones en el osciloscopio. El voltaje entre drenador y surtidor VDS con signo negativo se aplicará a la entrada horizontal del osciloscopio, operando en modo XY.

De la forma anterior es posible obtener una sola curva característica del FET y solo es cuestión de ejecutar de nuevo el voltaje VGS, para observar un nuevo trazo.

### UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUIVE DE LA CONTROL DE LA CONTROL

### DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

#### V.- PROCEDIMIENTO.

1.- Implementar el circuito de la figura 1.

2.- Con el multimetro digital mida el voltaje entre compuerta 2 surtidor VGS. Inicie con VGS=0 Volts desconectando ó apagando la fuente de alimentación E.

IV. TEORIA PRILIMINAR.

3.- Ajuste los controles del osciloscopio de la siguiente forma:

Acoplamiento de C.D.

200 mV/div inicialmente.

Modo XY.

Vernieres en posición de calibración.

4.-Observe lo siguiente:

Se forma una curva característica del FET.

La deflexión vertical es provocada por la caída en RD

lo que significa 2 mA/div.

La deflexión horizontal es provocada por el voltaje entre drenador y surtidor y es negativa.

5.- Ajuste el vernier de calibración de ganancia horizontal hasta tener un desplazamiento horizontal igual a 2 V/DIV.

El resultado de esto es una escala horizontal de 2 V/div.

En este paso utilice los controles de posición vertical y horizontal, para hacer que el origen de la curva este cerca de la esquina inferior derecha de la pantalla del osciloscopio.

6.- Dibuje una familia de curva característica para los siguientes valores de VGS. La curva se observa en el osciloscopio y se tiene que dibujar en la cuadricula.

VGS 0 -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -2.5 -3.0 V

Para cambiar el voltaje VGS, ajuste el valor de la fuente de alimentación E y mida solamente el voltaje VGS con el multimetro digital.

Etiquete a cada curva con el valor del voltaje VGS que le corresponde.

### VI.- SIMULACION.

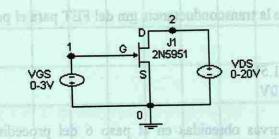


Figura 2. Circuito para obtener las curvas características del FET.

1.- Crear el archivo EXP09.CIR con la descripción del circuito de la figura 2.

7				TICAS DEL FET.
3 0	*Archivo	EXP09.C	IK	
nide)	VDS 2	0	0	2. Graficar la curva de resentrante del PET. Para e
A TOTAL	VGS 0	1	0	hactendo uso de la moltra de intruta obtanda en el man fed
1	J1 2	1	0	
	LIB FET	.LIB	- North	The state of the s
	.DC VD	S 0 20	0.1	VGS 0 3 0.5
	.PROBE			No. 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1
F 5	.END	1		

2.- En el graficador de alta resolución observar la familia de curvas características del FET.

Add-Trace ID(J1)

3.- Agregar el trazo de una linea de carga de CD, con los siguientes datos  $V_{DD} = 15$ ,  $R_{D} = 1K\Omega$ ,

 $RS = 0.5K\Omega$ .

Add-Trace (15 - VDS)/1.5K

4.- Imprimir la gráfica.

### DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

### VII.- REPORTE.

1.- Determinar el valor de la transconductancia gm del FET para el punto de operación dado

$$VGSQ = -1.5V$$
.  
 $VDSQ = 10V$ .

Emplear la familia de curvas obtenidas en el paso 6 del procedimiento. Para lograr lo anterior determine con VDS = 10V.

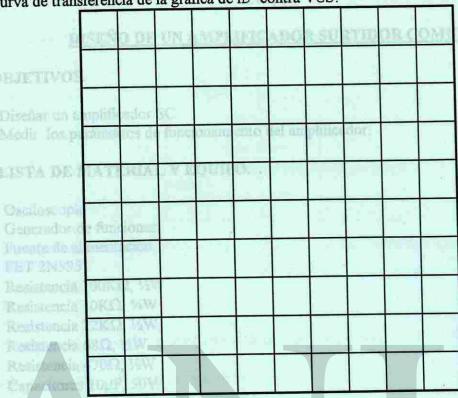
$$iD2 = VGS = -1.0V$$
 $iD1 = VGS = -2.0V$ 
 $vGS = -2.0V$ 

$$gm = \frac{\Delta^{r_i}}{\Delta VGS} = -$$

2.- Graficar la curva de transferencia del FET. Para ello complete la siguiente tabla, haciendo uso de la familia de curvas obtenida en el paso 6 del procedimiento.

4	VGS	0	-0.5	-1.0	-1.5	-2.0	-2.5	-3.0
V	iD			A STATE OF				

La curva de transferencia de la gráfica de iD contra VGS:



3.- De la curva de transferencia determine los siguientes valores característicos:

Corriente de saturación del drenador. Voltaje de estrangulamiento de la compuerta.

4.- Con la gráfica impresa en el paso 4 de la simulación, determina el valor de la transconductancia del FET, para VGSQ = -1.5V y VDSQ = 10V.

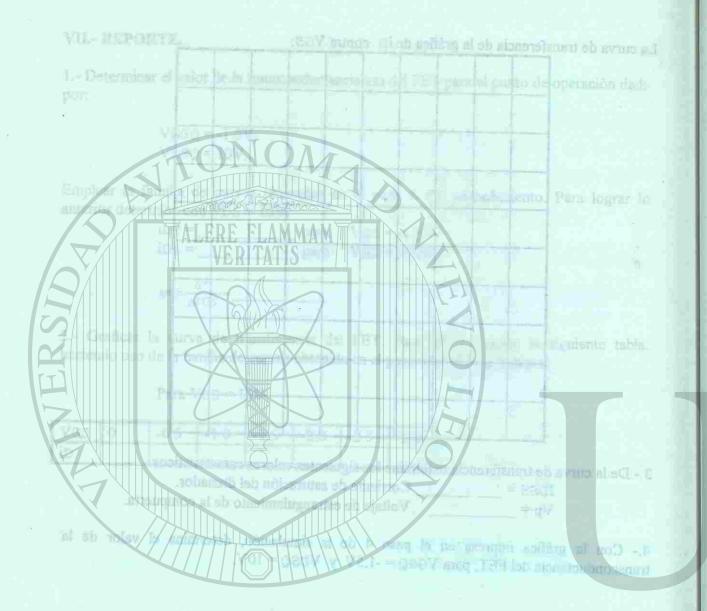
VI-SIMULACION.

# DAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

### DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

EXP109-6 FIME, Depto de Electrónica.

EXP109-7 FIME, Depto de Electrónica.



### EXP110 TWEETERS HAVE LEED OFFICE AREASTE

### DISEÑO DE UN AMPLIFICADOR SURTIDOR COMUN

### I.-OBJETIVOS.

- ☐ Diseñar un amplificador SC.
- ☐ Medir los parámetros de funcionamiento del amplificador.

### II.-LISTA DE MATERIAL Y EQUIPO.

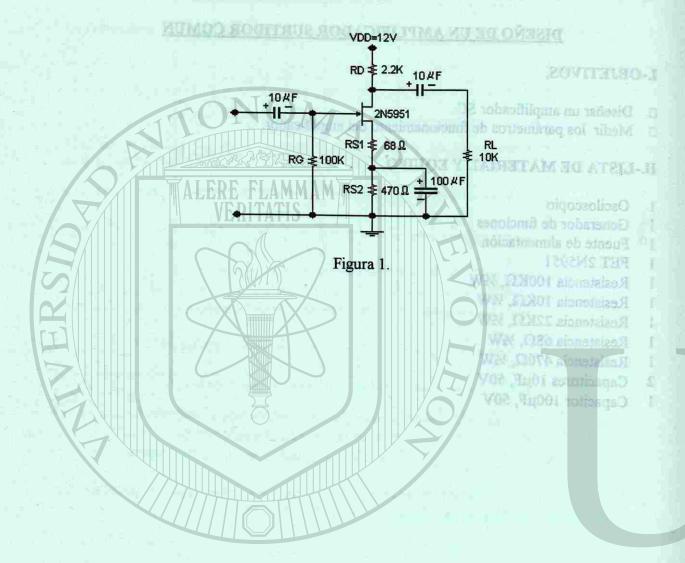
- 1 Osciloscopio
- 1 Generador de funciones
- 1 Fuente de alimentación
- 1 FET 2N5951
- Resistencia 100KΩ, ½W
- 1 Resistencia 10KΩ, ¼W
- Resistencia 22KΩ, ½W
- Resistencia 68Ω, ½W
- Resistencia 470Ω, ½W
- 2 Capacitores 10µF, 50V
- 1 Capacitor 100μF, 50V

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN

DIRECCIÓN GENERAL DE BIBLIOTECAS

EXP110-1 FIME, Depto. de Electrónica

### III.-CIRCUITO DEL EXPERIMENTO.



### IV.-TEORIA PRELIMINAR.

Se desea diseñar un amplificador surtidor-común, como el de la figura 1, y con las siguientes especificaciones:

Av ==-5

 $RL = 10K\Omega$ 

Rin = 100K $\Omega$ 

Usar el transistor JFET 2N5951 que tiene los siguientes parámetros:

Vp = -2.5V

IDSS =10mA

La fuente de alimentación disponible es de 12 volts, y se recomienda el siguiente punto de operación:

RD=19K Selectionar 2.2KO

IDQ = 2.5 mA

VDSQ =6V

Se procederá al diseño de acuerdo con el siguiente procedimiento:

### PASO 1.- Especificar punto de operación.

$$I_{DQ} = 2.5 mA$$

$$V_{DSQ} = 6V$$

$$g_{mo} = \frac{2I_{DSS}}{V_{P}}$$

$$g_{mo} = 8mmhos$$

$$g_m = g_{mo} \sqrt{\frac{I_{DQ}}{I_{DSS}}}$$

 $g_m = 4mmhos$ 

$$V_{GSQ} = V_p \left( 1 - \sqrt{\frac{I_{DQ}}{I_{DSS}}} \right)$$

 $V_{GSO} = -1.25V$ 

UNIVERSIDAD AUTÓNO MAD

DIRECCIÓN GENERAI

PASO2.- Plantear ecuaciones de funcionamiento.

Thyslocule Ri se puede determinar sebrando que

$$R_{S} + R_{D} = \frac{V_{DD} - V_{DSQ}}{I_{DQ}}$$

$$A_{V} = -g_{m} \frac{R_{D} / / R_{L}}{1 + g_{m} R_{S1}}$$

$$V_{GSQ} = -I_{DQ} R_{S}$$

$$R_{S} = R_{S1} + R_{S2}$$

Sustituyendo valores en las ecuaciones anteriores, se determinan los siguientes valores:

RD=1.9K	Seleccionar	2.2ΚΩ
Ω RS1=69	Seleccionar	47Ω
Ω RS2=431	Seleccionar	330Ω
Ω		

PASO 3.- Seleccionar RG

RG≥Rin RG=100KΩ

### UNIVERSIDAD AUTÓNO

DIRECCION GENERAL

EXP110-4 FIME, Depto. de Electrónica

#### V.- PROCEDIMIENTO.

- 1.- Implementar el circuito del amplificador SC de la figura 1. Observe que los valores corresponden al diseño planteado en la teoría preliminar.
- 2.- Medir el punto de operación, tomando lectura de los siguientes voltajes de CD con el multímetro digital:

VDD = VD = VG = (10187 117840 HJ 380) CDIS

3.- Observe que se cumplan las siguientes condiciones:

Si no se cumplen estas condiciones, revisar las conexiones, checar el transistor y analizar los pasos del 1 al 3 nuevamente.

- 4.- Aplique en la entrada del amplificador una señal senoidal de 5KHz y 200mVp-p aproximadamente. Observe en el osciloscopio las señales de entrada y de salida simultáneamente.
- 5.- Tomar lectura de las amplitudes de los voltajes de entrada y de salida

Vo = \_\_\_\_\_\_\_\_ Vi = \_\_\_\_\_\_

Observe que la señal de salida, esta invertida con respecto a la señal de entrada.

6.-Para medir el valor de la resistencia de entrada del amplificador, inserte una resistencia de  $100 \text{K}\Omega$  entre los puntos A y B.

Tome lectura con el osciloscopio de los siguientes voltajes (alternativamente puede utilizar el multimetro digital en voltaje de C.A.):

El valor de Ri se puede determinar sabiendo que

EXP110-5
FIME, Depto. de Electrónica

$$V_B = V_A \left( \frac{Ri}{100K + Ri} \right)$$

Al terminar retire del circuito la resistencia de  $100 \text{K}\Omega$ .

7.- Para medir la resistencia de salida del amplificador, tome nota de los siguientes voltajes de C.A.

Con la carga  $RL = 10K\Omega$  conectada.

Con una carga RL' =  $2.2K\Omega$  (use un nuevo valor)

La resistencia de salida se puede determinar de la siguiente relación:

$$\frac{Vo}{Vo'} = \frac{RL}{RL'} \left( \frac{Ro + RL'}{Ro + RL} \right)$$

JNIVERSIDAD AUTON

DIRECCIÓN GENERA

El valor de Ri sa puede determinar subtendo que

EXP110-6 FIME, Depto. de Electrónica

#### VI.- SIMULACION

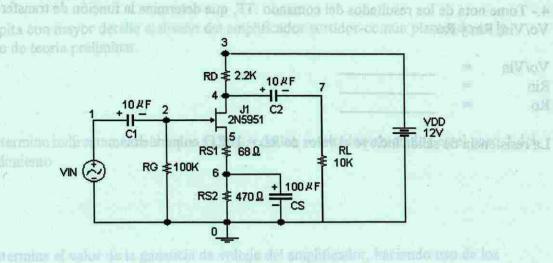


Figura 2. Amplificador Surtidor Común.

1.- Crear el archivo EXP10.CIR con la información del circuito amplificador SC de la figura 1.

AMP	LIFI	CADOR	SURTIDO	R COMUN
*Arch	ivo l	EXP10.C	CIR	
VIN	1	0	AC	ton la de vitrada del ampililizador, con los regulados del
VDD	3	0	DC	12
C1	2	1	10UF	
C2	4	7	10UF	
CS	6	0	100UF	
RG	2	0	100K	
RD	3	4	2.2K	HAT WELL THE HATER TOOK IN THE PERSON NOT THE PARTY.
RS1	5	6	68	
RS2	6	0	470	The state of the s
RL	7	0	10K	
J1	4	2	5	J2N5951
LIB.	FET	.LIB		
.TF V	7(7)	VIN		
.END	)	100		

- 2.- Los resultados de la simulación se pueden observar en el archivo de salida EXP10.OUT, para ello vea la opción FILE BROWSE.
- 3.- Tome nota de los voltajes del punto de operación:

VD = \_\_\_\_\_ VG = \_\_\_\_ VS = \_\_\_\_

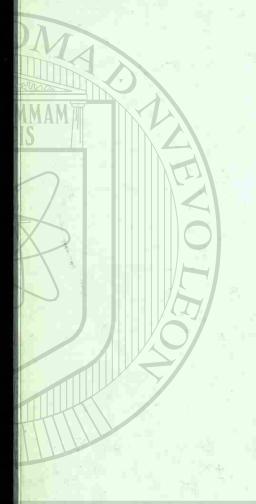
> EXP110-7 FIME, Depto. de Electrónica

VII.- REPORTE. 4.- Tome nota de los resultados del comando .TF, que determina la función de transferencia Vo/Vin, Rin y Ro. 1.- Repita con mayor detalle el diseño del amplificador surtidor-común planteado en la sección de teoría preliminar. Vo/Vin Rin Ro La resistencia de salida incluye el valor de RL =  $10K\Omega$  en paralelo. 2.- Determine indirectamente el valor de IDQ, con los resultados obtenidos en el paso 2 del procedimiento 3.- Determine el valor de la ganancia de voltaje del amplificador, haciendo uso de los resultados obtenidos en el paso 5 del procedimiento. 4.- Determinar el valor de la resistencia de entrada del amplificador, con los resultados del paso 6 del procedimiento. Compare con el valor teórico. 5.- Determine el valor de la resistencia de salida, con los resultados obtenidos en el paso 7 del procedimiento. 6.- Con los resultados obtenidos en el paso 3 de la simulación, determine el valor de IDQ. 7.- Determine el valor de la resistencia de salida del amplificador, tomando como base la Ro

> EXP110-8 FIME, Depto. de Electrónica

EXP110-9 FIME, Depto. de Electrónica

obtenida en el paso 4 de la simulación.



IDAD AUTÓNOMA DE NUEVO CCIÓN GENERAL DE BIBLIOTEC